

# Integrierte Schaltungen und Einzelhalbleiter Gesamtprogramm 1985

6200-179-1D

INTERMETALL semiconductors



## Kapazitätsdioden

### Si-Tuner-Dioden (gleichlaufsorrt geliefert)

Typ	Gehäuse	Kennwerte bei $T_U = 25^\circ\text{C}$											
		Kapazität		ausnutzbares Kapazitätsverhältnis			Serienwiderstand		Grenzfrequenz für $Q = 1$		Sperrstrom		
		$C_{\text{tot}}$ pF	bei $U_R$ V	$\frac{C_{\text{tot}}(\text{xV})}{C_{\text{tot}}(\text{yV})}$	bei xV	yV	$r_s$ $\Omega$	bei f MHz	$C_{\text{tot}}$ pF	$f_{Q1}$ GHz	bei $U_R$ V	$I_R$ nA	bei $U_R$ V
<b>BB221</b>	DO-35	1,8...2,2	28	8,0...9,5	1	28	0,55 (<0,7)	470	9	24	3	<30	30
<b>BB222</b>	DO-35	1,8...2,5	28	7,3...9,5	1	28	0,8 (<1)	470	9	16	3	<30	30
<b>BB329</b>	DO-35	2,5...3,2	28	>12	1	28	0,85	330	25	9	3	<30	30
<b>BB509</b>	23A3**	440...600	1	>15	1	9	–	–	–	–	–	<30	10
<b>BB521*</b>	DO-35	1,8...2,2	28	8...9,5	1	28	0,55 (<0,7)	470	9	24	3	<30	30
<b>BB529*</b>	DO-35	2,5...3,2	28	>12	1	28	0,85	330	25	9	3	<30	30
<b>BB621*</b>	MiniMELF	1,8...2,2	28	8...9,5	1	28	0,55 (<0,7)	470	9	24	3	<30	30
<b>BB622</b>	MiniMELF	1,8...2,5	28	7,3...9,5	1	28	0,8 (<1)	470	9	16	3	<30	30
<b>BB629*</b>	MiniMELF	2,5...3,2	28	>12	1	28	0,85	330	25	9	3	<30	30

\*Nachfolgetypen von BB221 bzw. BB329 mit verbesserter Linearität der Kennlinie  $C = f(U_R)$

\*\*Anschlüsse 1 und 2: Kathode, Anschluß 3: Anode